PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-281950

(43) Date of publication of application: 15.10.1999

(51)Int.CI.

G02F 1/133 G02B 5/30 G02F 1/1335 G02F 1/1337

G09G 3/18

(21)Application number: 10-085548

(71)Applicant : SANYO ELECTRIC CO LTD

(22)Date of filing:

31.03.1998

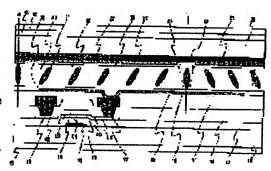
(72)Inventor: KOMA TOKUO

(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a liquid crystal display device which has a wide field angle and is free from persistence.

SOLUTION: In the liquid crystal display device where the direction of inclination of liquid crystal molecules 31 is designated by an electric field in an oblique direction at the edge of a picture element electrode 19 and that of an orientation control window 24, a phase plate 43 is provided between an upper polarizing plate 42 and liquid crystal 40. The phase plate 43 functions to cancel the phase difference in liquid crystal 40, and the transmittance is made minimum in the state that liquid crystal molecules 31 are slightly inclined. The lower end of an applied voltage is made slightly higher than a threshold to not only quicken the response but also maximize the contrast ratio.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

23.05.2000

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3421571

[Date of registration]

18.04.2003

[Number of appeal against examiner's decision of rejection] [Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection] [Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-281950

(43)公開日 平成11年(1999)10月15日

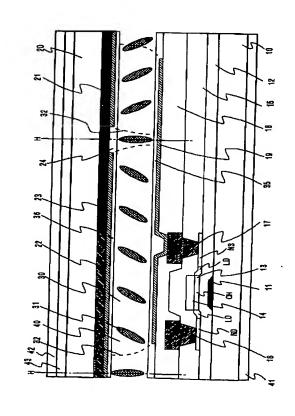
(51) Int.Cl. ⁸		識別記号	F I						
G02F	1/133	5 0 5	G02F	1/133	5	505			
G 0 2 B	5/30		G 0 2 B	5/30					
G 0 2 F	1/1335	5 1 0	G 0 2 F	1/1335	5	510			
	1/1337	5 0 5		1/1337	5	505			
G 0 9 G	3/18		G 0 9 G	3/18					
			審查請才	大請求	請求項の	0数3	OL	(全 8	頁)
(21)出顧番号	特願平10-85548		(71)出願人 000001889 三洋電機株式会社						
(22)出顧日	₩ .	成10年(1998) 3月31日	(守口市京阪	(本通	2丁目	5番5号	ŀ
			(72)発明者						
				大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三 洋電機株式会社内					
			(74)代理人	、弁理士	安富 耕	‡ 二	外 1名	5)	
	_								
	•								

(54) 【発明の名称】 液晶表示装置

(57)【要約】

【課題】 広視野角で、かつ、残像の無い液晶表示装置を得る。

【課題】 画素電極19エッジ及び配向制御窓24エッジにおける斜め方向電界により液晶分子31の傾斜方角を指定した液晶表示装置において、上側偏光板42と液晶40の間には位相板43が設けられている。位相差板43は液晶40における位相差を減殺する働きをし、液晶分子31が僅かに傾いた状態で透過率が最小となる。印加電圧の下端を関値よりも少し高くすることにより、レスポンスが速くなり、かつ、コントラスト比も最大となる。



30

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に液晶駆動用の電極が形成されてなる一対の電極基板間に液晶が挟持されてなる液晶表示 装置において、

前記液晶を駆動すべく印加する電圧は、液晶が駆動する 関値以上で、かつ、この印加電圧範囲の下端において、 最大または最小の透過率が得られることを特徴とする液 晶表示装置。

【請求項2】 前記一対の電極基板の外側には、偏光板が設けられ、少なくとも一方の前記電極基板と前記偏光 10板の間には、位相差板が設けられていることを特徴とする請求項1記載の液晶表示装置。

【請求項3】 前記電極には、所定のエッジを得るべく 電極の不在領域である配向制御窓が形成され、前記電極 のエッジまたは/及び前記配向制御窓のエッジにおい て、前記液晶が傾斜する方角が制御されることを特徴と する請求項1または請求項2記載の液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、液晶表示装置(L CD:liquid crystal display)に関し、特に、広視野 角で、かつ、レスポンスが速く、残像の無い液晶表示装 置に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、フラットパネルディスプレイとしてLCDが盛んに開発、生産されている。LCDは薄型、低消費電力などの点で優れており、OA機器、AV機器の分野で主流となっている。特に、各画素に画素情報の書き換えタイミングを制御するスイッチング素子としてTFTを配したアクティブマトリクス型LCDは、大画面、高精細の動画表示が可能となるため、各種テレビジョン、パーソナルコンピュータ、更には、携帯コンピュータ、デジタルスチルカメラ、ビデオカメラ等のモニターに多く用いられている。

【0003】TFTは絶縁性基板上に金属層とともに半 導体層を所定の形状に形成することにより得られる電界 効果型トランジスタ(FET: field effect transisto r)である。アクティブマトリクス型LCDにおいて は、TFTは、液晶を挟んだ一対の基板間に形成され た、液晶を駆動するための各キャパシタンスに接続され 40 ている。

【0004】図9はLCDの表示画素部の拡大平面図、

図10はそのB-B線に沿った断面図である。下側の透明な基板(50)上に、Cr、Ta、Mo等のメタルからなるTFTのゲート電極(51)がゲートライン
(1)と一体で形成され、これを覆ってSiNxまたは
/及びSiO2等からなるゲート絶縁膜(52)が形成されている。ゲート絶縁膜(52)上には、TFTの能動層となるp-Si(53)が形成されている。p-Si(53)は、この上にゲート電極(51)の形状にパ

ターニングされたSiO2等の注入ストッパー(54) を利用して、燐、砒素等の不純物を低濃度に含有した低 濃度 (LD: lightly doped) 領域 (LD)、及び、そ の外側に同じく不純物を高濃度に含有したソース及びド レイン領域(NS、ND)が形成されている。注入スト ッパー (54) の直下は、実質的に不純物が含有されな い真性層であり、チャンネル領域(CH)となってい る。これら、p-Si (53)を覆ってSiNx等から なる層間絶縁膜(55)が形成され、層間絶縁膜(5 5)上には、A1、Mo等からなるソース電極(56) 及びドレイン電極(57)が形成され、各々層間絶縁膜 . (55) に開けられたコンタクトホールを介して、ソー ス領域(NS)及びドレイン領域(ND)に接続されて いる。ドレイン電極(16)はドレインライン(2)と 一体で形成されている。このTFTを覆う全面には、S OG (SPIN ON GLASS), BPSG (BORO-PHOSPHO SILI CATE GLASS)、アクリル樹脂等の平坦化絶縁膜(58) が形成されている。平坦化絶縁膜(58)上には、IT O (indium tin oxide) 等の透明導電膜からなる液晶駆 動用の画素電極(59)が形成され、平坦化絶縁膜(5 8) に開けられたコンタクトホールを介してソース電極 (56)に接続されている。これらを覆う全面にはポリ イミド等からなる配向膜(71)が設けられている。こ の配向膜(71)は、実質的にプレチルト角が0°の垂 直配向膜である。以上、TFT基板が構成されている。 【0005】上側の透明な基板(60)上には、画素電 極(59)に対応する領域にR、G、Bのカラーフィル ター(61)と、その間隙に遮光膜(62)が形成され ている。この上の全面には、ITOからなる共通電極 (63)、及び、画素電極(59)に対向する領域にて ITOの不在部として形成された配向制御窓 (64) が 形成されている。この共通電極 (63) 上には、TFT

上、対向基板が構成されている。 【0006】これらTFT基板(50)と対向基板(6 0) の間には、負の誘電率異方性を有する液晶(80) が封入されている。更に、基板 (50) と基板 (60) の外側には、偏光軸方向(P、Q)を互いに直交させた 偏光板(91)(92)が設けられている。ここに挙げ たLCDにおいては、負の誘電率異方性を有した液晶分 子(81)は、垂直配向膜(71,72)により、初期 配向が実質的に基板の法線方向(H)になるように制御 されている。この場合、電圧無印加時には、下側から入 射した光は、下側の偏光板(91)を抜けて直線偏光と なり、液晶層(80)を通過して上側の偏光板(92) により遮断されて表示は黒として認識される。電圧印加 時には、下側の偏光板(91)を抜けた直線偏光は、液 晶層(80)にて複屈折を受け、楕円偏光に変化して上 側の偏光板(92)にて透過して、表示は白に近づいて 50 いく。この方式は、ノーマリプラック (NB) モードと

基板側と同じ垂直配向膜(72)が設けられている。以

呼ばれる。偏光軸(P、Q)を互いに平行に配した場合 は、逆に、電圧無印加時に表示は白となり、電圧印加に より黒に近づいていくので、このような方式は、ノーマ リホワイトモード (NW) と呼ばれる。

【0007】このLCDの特徴は、第1に、共通電極 (63) 内に配向制御窓 (64) を設け、第2に、液晶 (80)の初期配向をプレチルト無しの法線方向 (H)) に制御し、第3に、画素電極(59)の下地の 平坦化絶縁膜(58)により平坦性を高めた点にある。 この構成で、電圧印加により、画素電極(59)のエッ ジ及び配向制御窓(64)のエッジに、斜め方向の電界 (82)が生じ、液晶分子(81)は、斜め方向電界 (82)の傾斜方角とは逆の方角へ優先的に傾斜する。 この結果、液晶の連続体性のため、図9の矢印にて示す ように配向制御窓(64)を境にした各領域で異なる配 向に揃えられ、広視野角化が実現される。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このL CDでは、黒から白へ表示が変化する際、即ち、電圧無 印加の状態から、電圧印加により、液晶分子(81)が 法線方向(H)から傾斜する際、一瞬、配向が乱れ、斜 め方向電界(82)の作用により傾斜方角が決定して安 定な配向になるまで時間を要する。このため、プレチル トによりあらかじめ液晶の傾斜方角が一律に決められた 場合に比べ、レスポンスが遅くなる。この結果、残像を 生じ、表示品位を悪化させる問題があった。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明はこの課題を解決 するために成され、基板上に液晶駆動用の電極が形成さ れてなる一対の電極基板間に液晶が挟持されてなる液晶 表示装置において、前記液晶を駆動すべく印加する電圧 は、液晶が駆動する関値以上で、かつ、この印加電圧節 囲の下端において、最大または最小の透過率が得られる 構成である。

【0010】これにより、液晶は常時駆動された状態に されるので、レスポンスが速くなると共に、最大のコン トラスト比が得られる。特に、前記一対の電極基板の外 側には、偏光板が設けられ、光が入射する側の前記電極 基板と前記偏光板の間には、位相差板が設けられている 構成である。これにより、液晶の位相差と位相差板の位 相差により、印加電圧と透過率の関係が変えられ、閾値 以上の印加電圧で最小または最大の透過率が得られる。

[0011]

【発明の実施の形態】図1は、本発明の実施の形態にか かるLCDの表示画素部の平面図であり、図2はそのA -A線に沿った断面図である。下側の透明な基板 (1) 0) 上に、Cr、Ti、Ta等のゲート電極 (11) が 形成され、これを覆ってゲート絶縁膜(12)が形成さ れている。ゲート絶縁膜(12)上には、p-Si膜

に、島状に形成されている。p-Si膜(13)は、ゲ ート電極(11)の直上領域がノンドープのチャンネル 領域(CH)とされ、チャンネル領域(CH)の両側 は、燐等のN型不純物が低濃度にドーピングされたLD (lightly doped) 領域 (LD)、更にその外側は、同 じ不純物が高濃度にドーピングされたソース領域 (N S) 及びドレイン領域 (ND) となっており、LDD構 造とされている。

【0012】チャンネル領域(CH)の上には、LD領 10 域 (LD) を形成する際に、イオン注入時のマスクとし て用いられた注入ストッパー(14)が残されている。 p-Si膜(13)を覆って層間絶縁膜(15)が形成 され、層間絶縁膜(15)上にはドレイン電極(16) 及びソース電極(17)が形成され、各々層間絶縁膜 (15) に開口されたコンタクトホールを介して、p-Si膜(13)のドレイン領域(ND)及びソース領域 (NS) に接続されている。これらドレイン電極(1 6) およびソース電極 (17) を覆って、SOG、BP SG、アクリル樹脂等の平坦化絶縁膜(18)が形成さ れ、この平坦化絶縁膜(18)上にはITO (indium t in oxide) からなる画素電極 (19) が縦長の形状に形 成され、平坦化絶縁膜(18)に開口されたコンタクト ホールを介してソース電極(17)に接続されている。 この上には、ポリイミド等の配向膜(35)が形成され ている。この配向膜(35)は、プレチルト角を実質的 に0°、少なくとも、1°以内とする垂直配向膜であ

【0013】このTFT基板(10)に対向する位置に は、間に液晶層(40)を挟んで対向基板となる上側の 透明な基板 (20) が配置され、対向面にカラーフィル タ(21)、遮光膜(22)が形成され、これらの上に は、ITO等の共通電極(23)が形成されている。共 通電極(23)中には、画素電極(19)に対向する領 域内において、ITOの不在部として形成された配向制 御窓(24)が設けられている。配向制御窓(24) は、図1に示されているように、縦長の画素の中央部を 縦断するとともに、両端より 4 5°程度の角度をもって 二股に分かれ、画素の角部へ向かった形状とされてい る。共通電極(23)上には、基板(10)側と同じ垂 直配向膜(36)が設けられている。

【0014】また、TFT基板(10)及び対向基板 (20) の外側には、偏光軸方向 (P、Q) を互いに直 交する偏光板(41)(42)が設けられている。更 に、対向基板(20)と上側の偏光板(42)の間に は、本発明にかかる構成である、位相差板(43)が設 けられている。位相差板(43)は、ポリカーボネート やPVAが平面方向に一軸延伸されてなり、空間3方向 に関する屈折率 (nx, ny, nz) のうち、屈折率nxと屈 折率nyが異なる平面位相差板である。そして、屈折率 (13)が、ゲート電極(11)の上方を通過するよう 50 nxを有する光学軸Cは、図1に示すように、液晶分子

(31)が主として傾斜する方角Lと直交するように配置されている。この方角Lは、縦長の囲素電極 (19)のエッジ、及び、これに対応する配向制御窓 (24)の縦断線部分のエッジにより傾斜方角が制御された液晶分子 (31)が優勢となることにより決定されている。また、偏光軸方向 (P、Q)と光学軸C及び傾斜方角Lは互いに45°の角度をなしている。

【0015】例えば、液晶(30)の屈折率異方性は正で、位相差板(43)の屈折率異方性も正の場合、液晶分子(31)の傾斜方角Lと位相差板(43)の光学軸Cとを直交させると、後述するように、液晶(30)における位相差が減殺する作用が生じる。この結果、液晶分子(31)が僅かに傾斜した状態で、透過率が最小(ノーマリホワイト(NW)モードでは最大)となる。液晶(30)と位相差板(43)の屈折率異方性の極性が異なる場合は、液晶分子(31)の傾斜方角Lに対して、位相差板(43)の光学軸Cを平行に配することにより、同様の作用を生じさせることができる。位相差板(43)は、後述するように、液晶(30)における位相差を減殺する作用があり、液晶分子(31)が僅かに傾斜した状態で、透過率を最小(ノーマリホワイト(NW)モードでは最大)にする。

【0016】本発明のLCDは、以下のように、駆動される。図3は、NBモードにおける印加電圧Vと透過率Tの関係、図4は、NWモードにおける同様の関係を示す。また、図3(a)及び図4(a)は、本発明にかかる印加電圧Vと透過率Tの関係であり、図3(b)及び図4(b)は、各々の比較例であり、従来における同様の関係である。図3(a)あるいは図4(a)より、本発明では、印加電圧範囲Vrの下端Vdは、液晶が駆動する関値電圧Vtよりも高くなっており、液晶は常時駆動された状態にある。

【0017】本発明では、図2に示す如く、上側の基板 (20) と上側の偏光板(42)の間に位相差板(4 3)を設けたことで、液晶(30)における位相差が位 相差板(43)において減殺される構成となっている。 このため、V-T特性曲線が、図3(b)あるいは図4 (b) に示す従来のV-T特性曲線から変化する結果、 図3(a)及び図4(a)に示すように、下端電圧Vd が印加された状態で、透過率下値Td(透過率上値Tu) が最小値Tmin(最大値Tmax)に等しくなるような特性 となっている。即ち、下端電圧Vdが印加された時、液 晶(30)における位相差と位相差板(43)における 位相差とがちょうど相殺されているといえる。従って、 コントラスト比Tu/TdはTmax/Tminと等しく、最大 となる。なお、電圧無印加時には、透過率Tは、最小値 Tmin (最大値 Tmax) よりも少し高く (低く) なってい る。

【0018】そして、本発明では、表示が黒(白)から 灰あるいは白(黒)へ変化する際、液晶分子(31) は、既に、傾斜し、かつ、斜め方向電界 (32) により 傾斜の方角も決定された状態から、その傾斜角度を大き くするようにして、更に傾斜する。このため、完全に法 線方向 (H) を向いた状態から傾斜する場合よりも、レ スポンスが速くなる。

6

【0019】ただし、図3(b)及び図4(b)に示すように、レスポンスを速くするために、単に、印加電圧範囲の下端Vdを高めただけでは、透過率下値Td(透過率上値Tu)は最小透過率Tmin(最大透過率Tmax)よりも高く(低く)なってしまい、コントラスト比Tu/Tdは、最大コントラスト比Tmax/Tminよりも小さくなってしまう。これに対して、本発明では、図3(a)及び図4(a)に示すように、レスポンスを速くするために下端電圧Vdを高くしても、最大コントラスト比Tmax/Tminが得られる。

【0020】本発明の他の実施の形態として、位相差板(43)として、平面方向及び厚さ方向に光学的作用を有する空間位相差板を用いることができる。このような空間位相差板は、前述の平面位相差板に、更に、厚さ方向に光学的作用を有する垂直位相差板を重ね合わせることで得られる。垂直位相差板は、nzがnxやnyよりも小さな位相差板であるので、平面位相差板と組み合わせることで、nx,ny,nzが互いに異なる空間位相板となる。このように用いる垂直位相差板として、住友化学(株)社製のVACを用いることができる。空間位相差板は、視角の変化によって生じる液晶(40)における異常光成分を減少する方向に作用するので、広視野角化を実現することもできる。

【0021】更に、空間位相差板として、始めからn x, ny, nzが異なるものとして一体的に作製されたも のを用いることもできる。続いて、位相差板 (43) の 位相差を変えたときの、印加電圧Vと透過率Tとの関係 を、図5から図8を用いて説明する。図5は、位相差 (R) が20μmの場合、同様に図6はR=30μm、 図7はR=50μmの場合のV-T特性曲線を求めたシ ミュレーション結果である。また、図8は比較例であ り、位相差板(43)を用いない従来のV-T特性曲線 を求めたシミュレーション結果である。いずれもノーマ リプラックモードにおける特性を示している。なお、位 40 相差Rは、nyとnxの差に位相差板(43)の厚み、こ こでは100μmを乗算して得られる。また、全ての図 について、液晶 (30) の層厚は3. 6μmで、Δnは 0.10となっている。また、各図において、R、G、 Bの各色光についての特性曲線を示している。

【0022】これらの結果より以下のことが考察される。図5、図6及び図7では、透過率Tを極小とし、かつ、最小とする電圧値即ち下端電圧Vdが2.9V~3.0Vの範囲内にある。これに対して、図8では、0V~2.7Vの範囲で透過率Tは最小で、関値電圧Vt50が2.7V付近にあり、印加電圧Vがこれを越えると透

(5)

8

過率Tが上昇していることが分かる。この場合、最大のコントラスト比を得るためには、下端電圧Vdは2.7 V程度以下に設定される。本発明では、図5万至図7に示されているように、位相差板(43)を設けることで、関値電圧2.9 Vよりも高い下端電圧Vdにおいて、透過率Tが極小かつ最小となるような特性が得ることができる。また、下端電圧Vdは位相差Rが大きくなるに従って大きくなることが分かる。

[0023]

【発明の効果】垂直配向液晶を所定の方角へ傾斜させることで広視野角表示を行う液晶表示装置において、位相差板を設けて、印加電圧一透過率特性を変化し、液晶が駆動する関値より僅かに高い電圧で透過率が最小または最大となるように制御することにより、液晶は常時駆動された状態で、かつ、最大のコントラスト比を得ることができた。このため、液晶は、決められた方角へ僅かに傾斜した状態から所望の角度をもって傾斜するように電圧制御されるので、レスポンスが上昇し、残像の無い良好な表示が可能となった。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態かかる液晶表示装置の平面 図である。

【図2】図1のA-A線に沿った断面図である。

【図3】本発明にかかる液晶の駆動方法を示す印加電圧 -透過率特性図である。

【図4】本発明にかかる液晶の駆動方法を示す印加電圧 - 透過率特性図である。 【図5】本発明の実施の形態にかかる液晶表示装置における印加電圧-透過率特性図である。

【図6】本発明の実施の形態にかかる液晶表示装置における印加電圧-透過率特性図である。

【図7】本発明の実施の形態にかかる液晶表示装置における印加電圧-透過率特性図である。

【図8】従来の液晶表示装置における印加電圧-透過率 特性図である。

【図9】従来の液晶表示装置の平面図である。

0 【図10】図11のB-B線に沿った断面図である。

【符号の説明】

10 基板

11 ゲート電極

13 p - Si

16 ドレイン電極

17 ソース電極

18 平坦化絶縁膜

19 画素電極

20 基板

20 23 共通電極

24 配向制御窓

30 液晶層

31 液晶分子

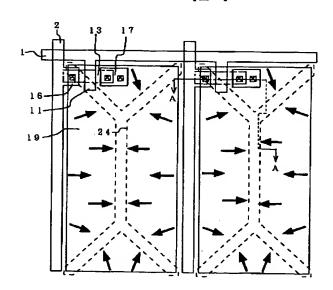
32 斜め方向電界

35,36 垂直配向膜

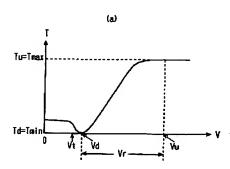
41,42 偏光板

43 位相差板

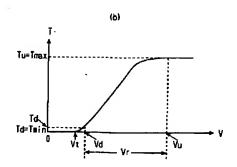
【図1】



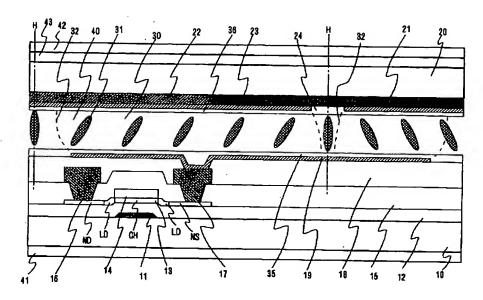
【図3】







【図2】

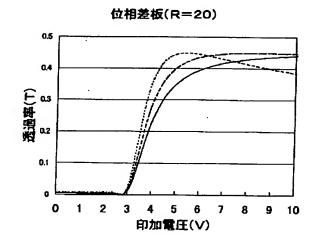


[図4]

(a) Td=Tein

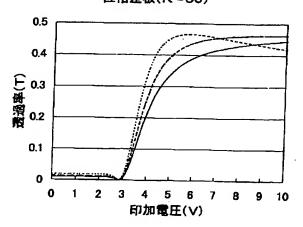
(b) Td=TminL 0

[図5]

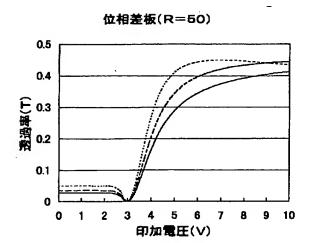


【図6】

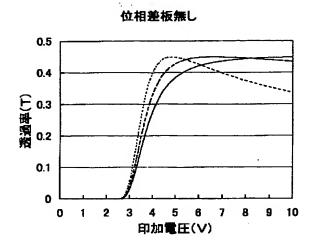
位相差板(R=30)



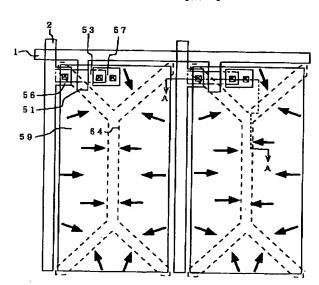
【図7】



【図8】

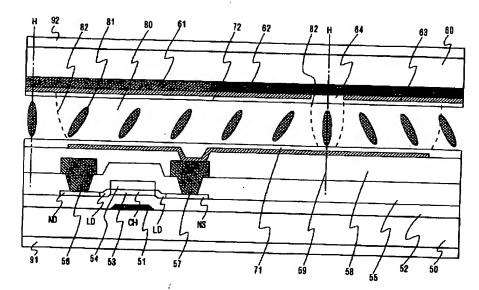


[図9]





[図10]



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.